

特点

- 2.7V至3.6V单电源
- 高速串行接口：66 MHz最大时钟频率
 - 兼容SPI模式0和3
- 用户可配置的页面大小
 - 每页256字节
 - 每页264字节
 - 页面大小可在工厂预先配置为256字节
- 页编程操作
 - 智能编程操作
 - 512页（二百六十四分之二百五十六字节/页）主内存
- 灵活的擦除选项
 - 页擦除（256字节）
 - 块擦除（2字节）
 - 擦除扇区（32字节）
 - 芯片擦除（1兆位）
- 一个SRAM数据缓冲区（264分之256字节）
- 通过整个阵列连续读取功能
 - 理想的代码映射应用程序
- 低功耗
 - 7毫安有效的读电流典型
 - 25 μA待机电流典型
 - 15 μA深度掉电典型
- 硬件和软件数据保护功能
 - 个别部门
- 部门锁定的安全代码和数据存储
 - 个别部门
- 安全性：128字节安全寄存器
 - 64字节的用户可编程空间
 - 唯一的64字节的设备标识符
- JEDEC标准制造商和设备ID读
- 100000编程/擦除周期每页最低
- 数据保留 - 20岁
- 工业温度范围
- 绿色（无铅/无卤化物/ RoHS标准）的包装选项

1. 描述

该AT45DB011D是2.7V，串行接口闪存非常适合各种数字支持语音，图像，程序代码和数据存储应用。该AT45DB011D支持要求非常高的应用高速串行接口速度操作。高速串行接口SPI的频率兼容多达66兆赫。其1081344位存储器组织为512页，每页256字节或264每个字节。除了在主存储器中，AT45DB011D还包含一个的二百六十四分之二百五十六字节的SRAM缓存。EEPROM仿真（位或字节变性）是很容易带有自包含三个步骤的读-修改-写操作进行处理。不像conventional与多个地址线和一个随机访问闪存，AT45DB011D采用了串行接口依次访问其数据。简单的顺序访问极大地降低了活动的引脚数，有利于硬件布局，提高了系统的可靠性，最大限度地降低开关噪声，并降低了封装尺寸。



1-megabit
2.7-volt
最低
数据闪存®

AT45DB011D

RapidS®

3639H-FLASH-04/09



图2-1 • SOIC顶视图

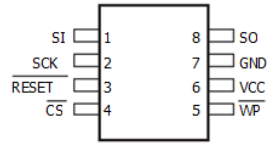
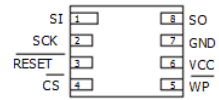
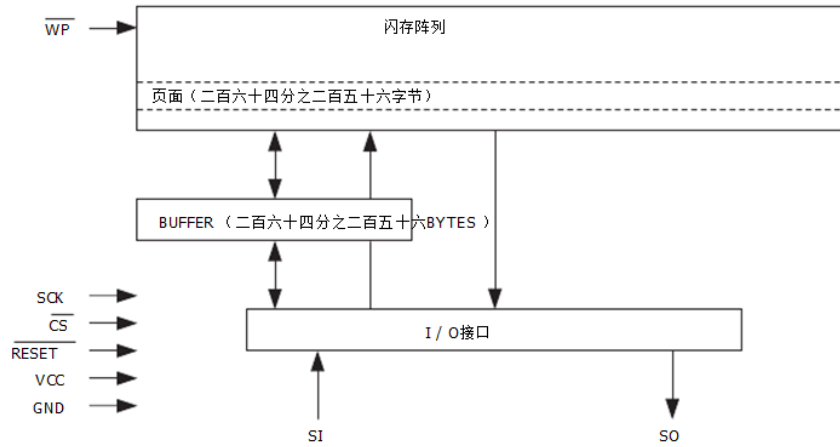


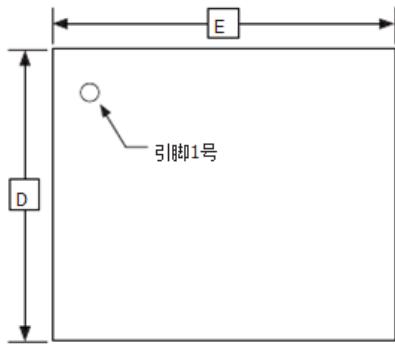
图2-2 • UDFN顶视图 (1)



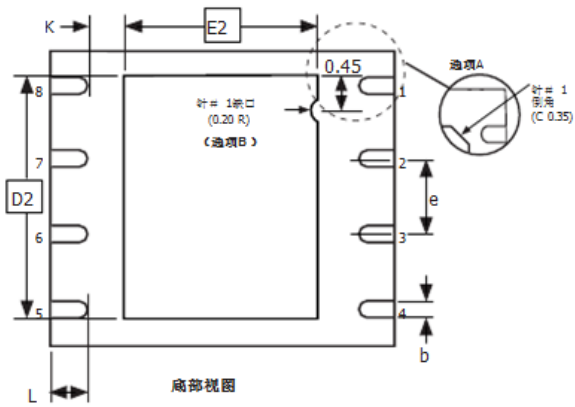
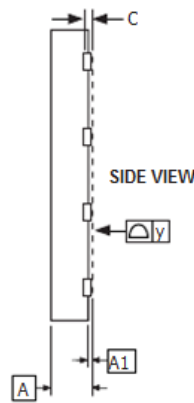
注意： 1.在UDFN封装底部的金属焊盘是浮动的。这种垫可以是“无连接”，或连接到GND。

3.框图





顶视图

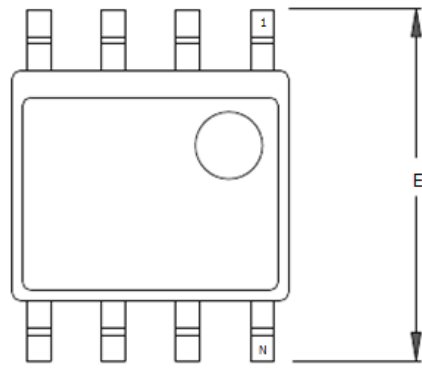


底部视图

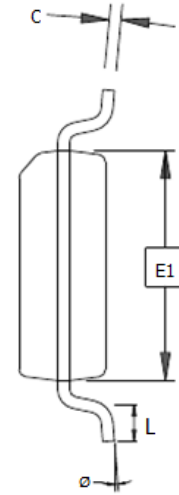
常见尺寸
(计量单位mm)

符号	长	宽	最大	记
A	0.45	0.55	0.60	
A1	0.00	0.02	0.05	
b	0.35	0.40	0.48	
C	0.152 REF			
D	4.90	5.00	5.10	
D2	3.80	4.00	4.20	
E	5.90	6.00	6.10	
E2	3.20	3.40	3.60	
e	1.27			
L	0.50	0.60	0.75	
y	0.00	-	0.08	
K	0.20	-	-	

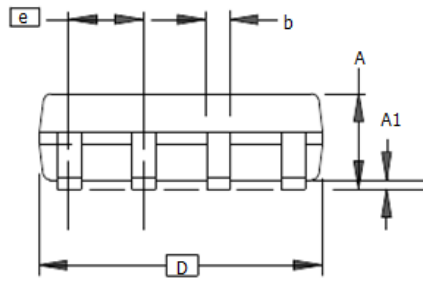
- Notes: 1. This package conforms to JEDEC reference MO-229, Saw Singulation.
2. The terminal #1 ID is a Laser-marked Feature.



顶视图



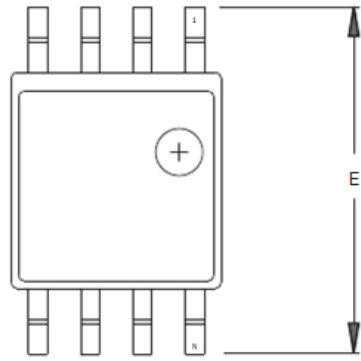
端视图



SIDE VIEW

常见尺寸
(计量单位mm)

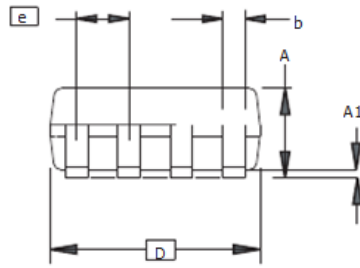
符号	低	高	最大	记
A	1.35	-	1.75	
A1	0.10	-	0.25	
b	0.31	-	0.51	
C	0.17	-	0.25	
D	4.80	-	5.05	
E1	3.81	-	3.99	
E	5.79	-	6.20	
e	1.27 BSC			
L	0.40	-	1.27	
θ	0°	-	8°	



顶视图



端视图



SIDE VIEW

常见尺寸
(计量单位mm)

符号	底	嘴	最大	记
A	1.70		2.16	
A1	0.05		0.25	
b	0.35		0.48	4
C	0.15		0.35	4
D	5.13		5.35	
E1	5.18		5.40	2
E	7.70		8.26	
L	0.51		0.85	
?	0°		8°	
e	1.27 BSC			3